

特徴

- PCBまでの低い熱抵抗
(0.5°C/W以下)
- 連続100Aまで可能な高電流パッケージ
- ゲート抵抗100%試験済
- 0.9mmと低背
- 業界標準のピン配置
- 既存の表面実装技術と互換性あり
- 鉛フリー、臭化物フリー、ハロゲンフリー
(RoHS準拠)
- 耐湿性レベル：MSL1取得

アプリケーションと用途

- 通信・テレコム向け絶縁型 DC-DCコンバータの1次側および2次側スイッチ
- AC-DCスイッチング電源の2次側スイッチ
- モーター駆動のスイッチ

IRのアドバンテージ

- 電力密度を向上
- 高信頼性
- 他社製品との互換性あり
- 製造が容易
- 環境に配慮した製品



高電流対応のPQFN5×6mmパッケージに 封止した中耐圧のパワーMOSFET

IR社は中耐圧のHEXFET®パワーMOSFETデバイスの製品群を、高電流対応の5×6mmのPQFNパッケージで拡充、提供します。

新しいパワーMOSFETはIR社の最新の半導体技術を採用し、スイッチング用途向けに最適化されています。例えば、通信／ネットワーク機器向けのDC-DCコンバータ、スイッチング電源（SMPS）、モーター駆動のスイッチなどの用途に適しています。40V～250Vの幅広い耐圧に対応し、オン抵抗（内部抵抗）やゲート電荷が異なるさまざまな製品をそろえているので、用途に応じて性能と価格に見合った製品を選べます。

0.9mmと低背で、業界標準ピン配列のこのデバイスは高電流定格・低オン抵抗で、複数の並列部品を必要とする他のソリューションと比べて、高効率、高電力密度、高信頼性を提供します。基板スペースの限られたスイッチング・アプリケーションにも最適です。

仕様

型番	パッケージ	耐圧	ドレイン電流*1	オン抵抗*2	ゲート電荷 (標準値)	ゲート入力
IRFH5004TRPbF	PQFN 5×6mm	40V	100A	2.6mΩ	73nC	標準
IRFH5006TRPbF	PQFN 5×6mm	60V	100A	4.1mΩ	67nC	標準
IRFH5106TRPbF	PQFN 5×6mm	60V	100A	5.6mΩ	50nC	標準
IRFH5206TRPbF	PQFN 5×6mm	60V	89A	6.7mΩ	40nC	標準
IRFH5406TRPbF	PQFN 5×6mm	60V	40A	14.4mΩ	23nC	標準
IRFH5007TRPbF	PQFN 5×6mm	75V	100A	5.9mΩ	65nC	標準
IRFH5207TRPbF	PQFN 5×6mm	75V	71A	9.6mΩ	39nC	標準
IRFH5010TRPbF	PQFN 5×6mm	100V	100A	9.0mΩ	65nC	標準
IRFH5110TRPbF	PQFN 5×6mm	100V	63A	12.4mΩ	48nC	標準
IRFH5210TRPbF	PQFN 5×6mm	100V	55A	14.9mΩ	39nC	標準
IRFH5015TRPbF	PQFN 5×6mm	150V	56A	31mΩ	33nC	標準
IRFH5020TRPbF	PQFN 5×6mm	200V	43A	55mΩ	36nC	標準
IRFH5025TRPbF	PQFN 5×6mm	250V	32A	100mΩ	37nC	標準
IRLH5034TRPbF	PQFN 5×6mm	40V	100A	2.4mΩ	43nC	論理レベル
IRLH5036TRPbF	PQFN 5×6mm	60V	100A	4.4mΩ	44nC	論理レベル
IRLH5030TRPbF	PQFN 5×6mm	100V	100A	9.0mΩ	44nC	論理レベル

*1 パッケージ温度25°Cのときの最大値

*2 ゲート-ソース間電圧10Vのときの最大値



HEXFET®はインターナショナル・レクティブファイアー社の登録商標です。